

### Proprietà

- Realizzato con 36 celle ad alta efficienza in silicio policristallino da 156 x 156 mm
- Stabilità delle prestazioni elettriche nel tempo grazie all'utilizzo di sole materie prime di qualità e di tecnologia al silicio cristallino
- Ridotta tolleranza sulla potenza di uscita, +/-5%, che minimizza le perdite per mismatch
- Particolarmente adatto per l'utilizzo in impianti con accumulatori (elettrificazione rurale, rilevamento dati, telecomunicazioni, applicazioni speciali)
- Scatola di giunzione stagna IP65 - Classe di isolamento II
- Cornice in alluminio anodizzato con 8 fori asolati che facilita e velocizza l'installazione del modulo

### Affidabilità e garanzie

- Affidabilità del modulo grazie a quasi 30 anni di esperienza nel settore FV
- Garanzia di 5 anni sui materiali e sui difetti di fabbricazione
- Garanzia di potenza non inferiore al 90% in 10 anni e 80% in 25 anni

### Caratteristiche elettriche alle STC (1000W/m<sup>2</sup>, 25°C, AM 1,5)

| MODELLO                             | HTB115P | HTB125P | HTB135P |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Potenza del modulo (Pmax)           | 115 Wp  | 125 Wp  | 135 Wp  |
| Tensione di massima potenza (Vpmax) | 17,20 V | 17,20 V | 17,70 V |
| Corrente di massima potenza (Ipmax) | 6,69 A  | 7,27 A  | 7,63 A  |
| Tensione a circuito aperto (Voc)    | 21,80 V | 21,80 V | 22,40 V |
| Corrente di corto circuito (Isc)    | 7,24 A  | 7,87 A  | 8,18 A  |
| Tensione massima di sistema         | 715 V   |         |         |
| Tolleranza sui valori di potenza    | +/- 5%  |         |         |

### Caratteristiche operative

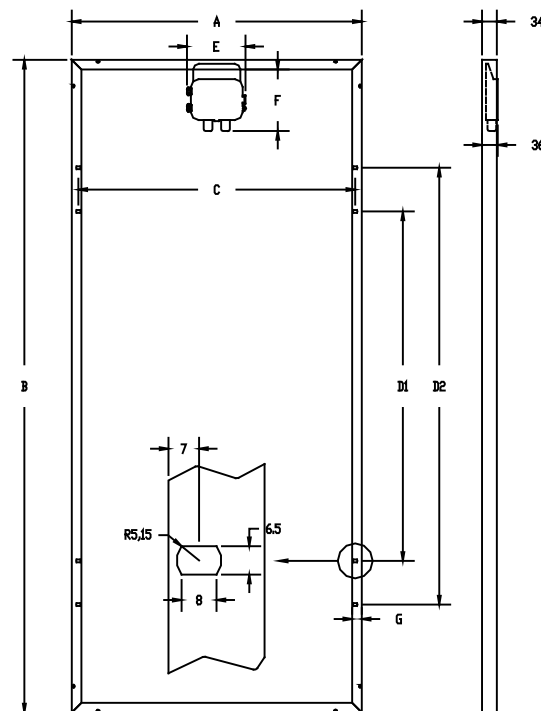
|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Coefficiente di temperatura Isc (α)  | +0,10% / °C           |
| Coefficiente di temperatura Voc (β)  | -0,35% / °C           |
| Coefficiente di temperatura Pmax (γ) | -0,49% / °C           |
| Carico massimo superficiale          | 2400 N/m <sup>2</sup> |
| Temperatura di esercizio             | da -40 a +85 °C       |
| Resistenza impatto gradine           | Ø 25 mm a 83 km/h     |

### Caratteristiche fisiche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lunghezza - B                | 1494 ± 1 mm                             |
| Larghezza - A                | 664 ± 1 mm                              |
| Interasse - C                | 634 mm                                  |
| Interasse - D1               | 800mm                                   |
| Interasse - D2               | 1000mm                                  |
| Larghezza Junction Box - E   | 135mm                                   |
| Altezza Junction Box - F     | 145 mm                                  |
| Ingombro interno cornice - G | 22 mm                                   |
| Spessore cornice             | 34 mm                                   |
| Peso                         | 11,4 kg                                 |
| Vetro frontale               | Vetro a basso contenuto di Fe da 3,2 mm |
| Incapsulante                 | EVA (Etilene-Vinil Acetato)             |
| Backsheet                    | Multistrato a base di poliestere        |
| Cornice                      | Al anodizzato 6060 T5 - 15um            |
| <b>CELLE</b>                 |   |
| Tecnologia                   | Silicio multicristallino                |
| Dimensioni                   | 156 x 156 mm                            |
| Layout                       | 36 (4 file x 9 celle)                   |



Helios Technology si riserva il diritto di effettuare variazioni alle caratteristiche tecniche senza preavviso.



Helios Technology S.p.A.

 Via Postumia, 9/B  
 35010 Carmignano  
 di Brenta (PD) - Italy

 Tel. +39.049.9430288  
 Fax +39.049.9430323  
 info@heliostechnology.com  
 www.heliostechnology.com
